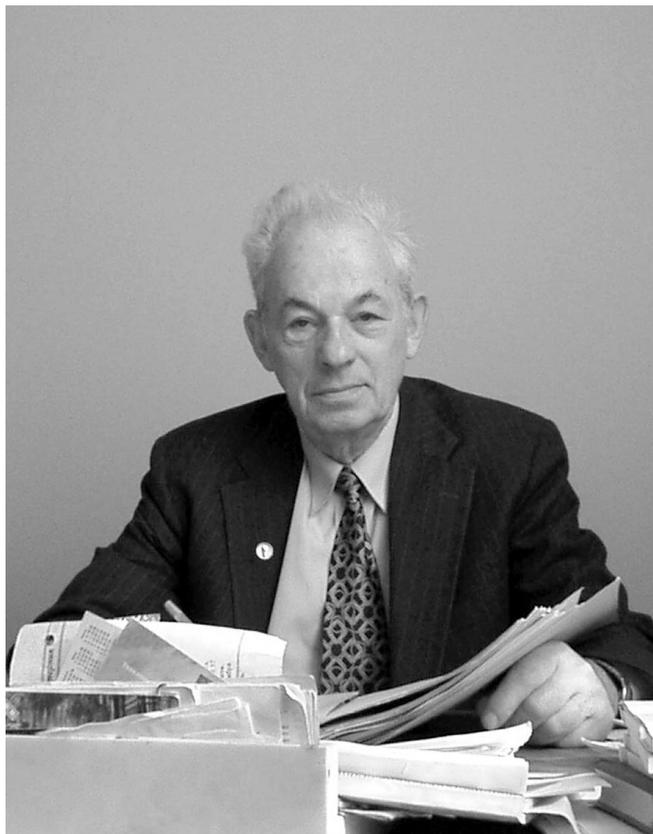


Виктор Ильич Фистуль

(к семидесятипятилетию со дня рождения)



1 мая 2002 года исполнилось 75 лет Виктору Ильичу Фистулю — академику Российской академии естественных наук, доктору физико-математических наук, профессору Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова (МИТХТ).

После окончания в 1949 г. физико-механического факультета Ленинградского политехнического института В.И. Фистуль работал мастером ОТК, инженером и старшим инженером заводской лаборатории на заводе „Уралэлектроаппарат“ в г. Свердловск (ныне Екатеринбург). С 1952 по 1964 г.г. он работал в Научно-исследовательском институте электронной промышленности, а с 1964 по 1977 г.г. трудился в Научно-исследовательском институте редкометаллической промышленности (Гиредмет), в котором он прошел путь от старшего научного сотрудника до заведующего физическим отделом.

В конце 50-х годов в нашей стране начала бурно развиваться полупроводниковая электроника, и с 1959 г. научные интересы В.И. Фистуля прочно и надолго оказались связанными с полупроводниками. Они явились тем объектом научных исследований, для которого наи-

более отчетливо видна связь между двумя важнейшими естественными науками — физикой и химией. Характеристики полупроводниковых материалов зависят от природы и ничтожно малых концентраций примеси. Эта связь привлекла внимание Виктора Ильича и связала его самого с тайнами состояния и поведения примесей в этих кристаллах. Именно этому направлению посвящена большая часть научных работ В.И. Фистуля.

Всемирно известны его исследования сильнолегированных полупроводников. Они привели его к обнаружению и объяснению политропии (многоформия) примесей в полупроводниках. Результаты этих исследований обобщены В.И. Фистулем в двух монографиях: „Сильнолегированные полупроводники“ (1965 г.) и „Распад пересыщенных полупроводниковых твердых растворов“ (1977 г.). Выполненные под руководством В.И. Фистуля исследования примесных атомов с частично заполненными электронными оболочками в полупроводниках A^{IV} и $A^{III}B^V$ позволили установить основные закономерности их поведения. Эти исследования нашли отражение в монографии „Примеси переходных металлов в полупроводниках“ (1983 г.), написанной совместно с его учеником Э.М. Омеляновским.

Результатом изучения газообразующих примесей в кристаллах A^{IV} явилось открытие (№ 259, 1983 г.) глубокого донорного состояния водорода в германии и кремнии. Большой вклад внес В.И. Фистуль с учениками в изучение теории поведения амфотерных и изоэлектронных примесей в кристаллах $A^{III}B^V$. В 1992 г. им была опубликована монография „Амфотерные примеси в полупроводниках“.

В 1962 г. В.И. Фистуль совмещает научную работу в Гиредмете с преподаванием в МИТХТ, где в 1977 г. становится заведующим кафедрой „Технология полупроводниковых материалов“. В 1985 г. в МИТХТ по его инициативе создается кафедра „Физика и химия твердого тела“, заведующим которой он был до 1991 г., а сегодня продолжает работать на этой кафедре в должности профессора.

В.И. Фистуль проявил себя как замечательный педагог. Фактически он стал организатором научно-педагогической школы по полупроводниковому материаловедению в МИТХТ, которая явилась прекрасной кузницей научных и педагогических кадров.

Под его руководством выполнено 6 докторских и 47 кандидатских диссертаций. В.И. Фистуль является автором 225 статей, 8 монографий, 4 учебников для высшей школы, научно-популярной книги для старших школьников. Его двухтомный учебник „Физика и химия твердого тела“ (1995 г.) получил широкое признание специалистов.

За научные достижения В.И. Фистуль удостоен звания „Заслуженный деятель науки и техники РФ“, отмечен Государственными премиями СССР в области науки и техники (1975 г., 1987 г.), награжден медалями им. академика Курнакова (1985 г.), академика Капицы (1995 г.), Петра I (1996 г.), дипломом Международного биографического центра „За научные заслуги“ (2000 г.). В 1998 г. Международный биографический центр присвоил В.И. Фистулю почетное звание „Человек года“. Ханойский технический университет избрал его почетным профессором.

Со дня основания журнала „Физика и техника полупроводников“ на протяжении многих лет В.И. Фистуль был членом его редколлегии.

В настоящее он по-прежнему активно трудится в науке, в подготовке инженерных и научных кадров, в издательской деятельности.

Виктор Ильич Фистуль — всесторонне образованный и обаятельный человек, уважаемый всеми, кто сотрудничает и встречается с ним.

Мы желаем Виктору Ильичу здоровья, оптимизма, творческого долголетия.

*Коллеги по работе в МИТХТ,
Редколлегия журнала „Физика и техника полупроводников“*